

**RadioMart — Казахстан**

Актуальные адрес и часы работы:

<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

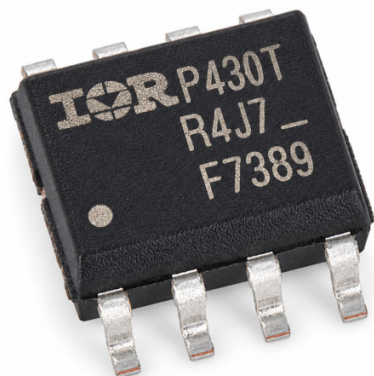
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 19143**

**Цена в прайсе: 605 тг.**

**MOSFET транзистор IRF7389TRPBF, N+P-канал,  $\pm 30$  В, 7,3/-5,3 А, SO-8**



**RF7389TRPBF** — комплементарная пара силовых MOSFET производства Infineon / International Rectifier: один **N-канальный 30 В, 7,3 А** и один **P-канальный -30 В, -5,3 А** транзистор в общем корпусе **SO-8**. Максимальное сопротивление открытого канала при  $V_{GS} = \pm 10$  В составляет **29 мОм** для **N-канала** и **58 мОм** для **P-канала**.

IRF7389TRPBF — сдвоенный силовой HEXFET MOSFET, содержащий в одном корпусе комплементарную пару **N-channel + P-channel**.

Такое исполнение удобно для построения полумостовых схем, управления нагрузкой, DC/DC-преобразователей и других схем, где требуется пара MOSFET противоположной полярности. Производитель отдельно указывает **Complementary Half Bridge**, низкое  $R_{DS(on)}$ , высокую скорость переключения и avalanche-rated конструкцию.

N-канальная часть рассчитана на напряжение сток-исток **30 В** и непрерывный ток до **7,3 А** при  $T_A = 25$  °С. Для P-канальной части соответствующие максимальные значения составляют **-30 В** и **-5,3 А**. При  $T_A = 70$  °С допустимый ток уменьшается до 5,9 А и -4,2 А соответственно. Импульсный ток составляет до  **$\pm 30$  А**.

При напряжении затвор-исток 10 В максимальное  $R_{DS(on)}$  составляет **29 мОм** для **N-канала** и **58 мОм** для **P-канала**. При управлении от 4,5 В максимальные значения увеличиваются до **46** и **98 мОм** соответственно.

#### **Характеристики**

- **Производитель:** Infineon Technologies / International Rectifier
- **Точная маркировка:** IRF7389TRPBF
- **Серия:** HEXFET

- **Тип:** сдвоенный силовой MOSFET
- **Конфигурация:** N-channel + P-channel
- **Количество MOSFET:** 2
- **Напряжение VDS, N-канал:** 30 В
- **Напряжение VDS, P-канал:** –30 В
- **Постоянный ток ID, N-канал:** 7,3 А при TA = 25 °C
- **Постоянный ток ID, P-канал:** –5,3 А при TA = 25 °C
- **Ток при TA = 70 °C, N/P:** 5,9 / –4,2 А
- **Импульсный ток IDM:** +30 / –30 А
- **Максимальное VGS:** ±20 В
- **RDS(on), N-канал:** ≤29 мОм при VGS = 10 В
- **RDS(on), P-канал:** ≤58 мОм при VGS = –10 В
- **RDS(on), N-канал при 4,5 В:** ≤46 мОм
- **RDS(on), P-канал при –4,5 В:** ≤98 мОм
- **Общий заряд затвора Qg, N-канал:** тип. 22 нКл
- **Общий заряд затвора Qg, P-канал:** тип. 23 нКл
- **Входная ёмкость Ciss, N-канал:** тип. 650 пФ
- **Входная ёмкость Ciss, P-канал:** тип. 710 пФ
- **Максимальная рассеиваемая мощность:** 2,5 Вт при TA = 25 °C
- **Тепловое сопротивление переход-окружающая среда RθJA:** до 50 °C/Вт
- **Температура перехода и хранения:** –55...+150 °C
- **Корпус:** SO-8
- **JEDEC:** MS-012AA
- **Количество выводов:** 8
- **Монтаж:** SMD

Параметры приведены по официальному datasheet и странице Infineon.

## Распиновка

Вид сверху:

- **1 – S1:** Source N-channel
- **2 – G1:** Gate N-channel
- **3 – S2:** Source P-channel
- **4 – G2:** Gate P-channel
- **5, 6 – D2:** Drain P-channel
- **7, 8 – D1:** Drain N-channel

Распиновка подтверждается схемой корпуса в официальном datasheet.